

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

改訂版

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2013年3月7日(07.03.2013)



(10) 国際公開番号
WO 2013/031554 A9

- (51) 国際特許分類:
H01L 21/308 (2006.01) *H01L 23/522* (2006.01)
H01L 21/768 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2012/070895
- (22) 国際出願日: 2012年8月17日(17.08.2012)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2011-189633 2011年8月31日(31.08.2011) JP
- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 林純薬工業株式会社(Hayashi Pure Chemical Ind., Ltd.) [JP/JP]; 〒5400037 大阪府大阪市中央区内平野町3丁目2番12号 Osaka (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 松井 篤史(MATSUI, Atsushi) [JP/JP]; 〒5400037 大阪府大阪市中央区内平野町3丁目2番12号 林純薬工業株式会社内 Osaka (JP). 木村 真弓(KIMURA, Mayumi) [JP/JP]; 〒5400037 大阪府大阪市中央区内平野町3丁目2番12号 林純薬工業株式会社内 Osaka (JP). 田湖 次広(TAGO, Tsuguhiko) [JP/JP]; 〒5400037 大阪府大阪市中央区内平野町3丁目2番12号 林純薬工業株式会社内 Osaka (JP).
- (74) 代理人: 伊藤 英彦, 外(ITO, Hidehiko et al.); 〒5420082 大阪府大阪市中央区島之内1丁目21番19号 オリエンタル堺筋ビル アイミー国際特許事務所 Osaka (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告(条約第21条(3))
- (88) 改訂された国際調査報告の公開日: 2014年3月20日
- (15) 訂正情報:
2014年3月20日の更新情報(Notice)を参照

(54) Title: ETCHING LIQUID COMPOSITION AND ETCHING METHOD

(54) 発明の名称: エッチング液組成物およびエッチング方法

(57) Abstract: An etching liquid composition which is used for etching a film that contains silicon and is formed on a substrate to be processed. This etching liquid composition contains hydrofluoric acid, ammonium fluoride, an organic acid and at least one substance that is selected from the group consisting of hydroxy group-containing organic compounds, carbonyl group-containing organic compounds, inorganic acids and inorganic acid salts.

(57) 要約: 被処理基板上に形成されたシリコンを含む膜のエッチングを行う際に用いられるエッチング液組成物であって、エッチング液組成物は、含ヒドロキシ基有機化合物、含カルボニル基有機化合物、無機酸、および無機酸塩からなる群から選択される少なくとも一つと、フッ化水素酸と、フッ化アンモニウムと、有機酸とを含む。



WO 2013/031554 A9